

**Программа научно-технической конференции молодых
специалистов на 29 апреля 2014 г.**

Начало конференции в 10.30-17.00

Место проведения: г. Санкт-Петербург, пр. Тореза. 68, Малый зал

Регламент выступления:

Доклад – 10 мин.

Вопросы – 10 мин.

Обед: 13.00-14.00

Открывает научно-техническую конференцию зам.Ген.директора по научной
работе Татаурщиков Сергей Сергеевич.

№	ФИО	Тема доклада	Название организации
1	Андреев Л.Д.	Дистробоскопический метод индикации резонанса конструкции	ОАО «ЦНИИ «Электрон», отдел 82
2	Зограбян Армине Коляевна	Повышение радиационной стойкости прибора ЛИ-501 за счет толщины фотопроводящего слоя	ООО «Электрон-Комплект»
3	Яковлев Г.Е.	Концентрационное профилирование полупроводниковых структур электрохимическим методом	СПбГЭТУ (ЛЭТИ), каф. МНЭ
4	Комков О.С., Фирсов Д.Д.	Оптические характеристики автоэпитаксиального слоя InAs, освещаемого через сильнолегированную подложку	СПбГЭТУ (ЛЭТИ)
5	Качалин Андрей	Перспективы внедрения FMEA на предприятии «ЦНИИ «Электрон»	ОАО «ЦНИИ «Электрон», 21 отдел
6	Ламкин И.А.	Фотодиоды на основе твердых растворов $Al_xGa_{1-x}N$ и GaP	СПбГЭТУ (ЛЭТИ)
7	Ковалишина Е.А.	Измерение толщины эпитаксиального слоя фоточувствительной мишени ФПУ «Катер»	
8	Красный Иван Борисович	Разработка технологии получения толстых медных слоев на керамических подложках	«Новосибирский государственный технический университет», каф.электронных приборов
9	Качалин Андрей	Комплекс мероприятий, направленных на повышение эффективности работы предприятия	ОАО «ЦНИИ «Электрон», 21 отдел
10	Горчаков О.И., Киселев А.С., Смирнов Е.А.	Исследование характеристик светодиодов в учебном процессе	СПбГЭТУ (ЛЭТИ)
11	Бабинов Н.А., Барченко В.Т.	Источник быстрых нейтронов с пониженным рабочим давлением	СПбГЭТУ (ЛЭТИ)
12	Гальтер Диана Павловна	1. Результаты исследования фотолуминесценции пористого кремния 2. Исследование спектральных характеристик фильтров и просветляющих покрытий, используемых в разрабатываемых ФЭП, на спектрофотометре СФ-256	ОАО «ЦНИИ «Электрон», НПКО-25
13	Дзюбий Александр Владимирович	Методика фотометрирования сенда для измерения фотоэлектрических параметров фоточувствительного сенсора для диапазона 1÷4 мкм.	ОАО «ЦНИИ «Электрон», НПКО-25
14	Таиров Денис Михайлович	Основные характеристики и возможности сенда, предназначенного для измерения спектральной чувствительности ФЭП	ОАО «ЦНИИ «Электрон», НПКО-25